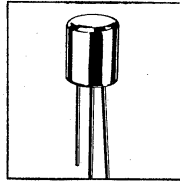


2SK24

シリコンNチャネル接合型FET
AM RF増幅, AF前置増幅用



☆AM RF アンプから AF プリアンプ用まで幅広い用途に適します。

★Silicon N-channel junction type FET.

★For AM RF amplifier and AF preamplifier.

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

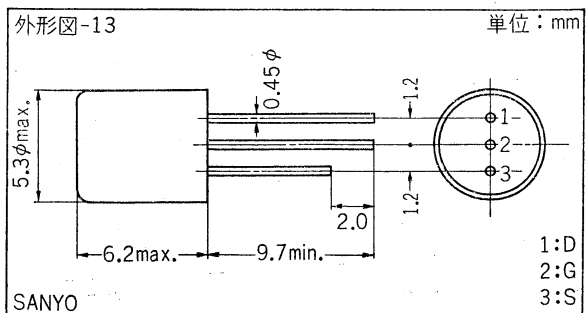
項 目	記 号	2SK24	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	40	V
ドレイン・ゲート間電圧	V_{GDS}	-40	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSO}	-40	V
ゲート電流	I_G	10	mA
許容損失	P_D	100	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-40~+125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項 目	記 号	条 件	min.	typ.	max.	単 位
ゲート・ドレイン間降伏電圧	B. V_{GDS}	$I_G = -10\mu\text{A}$	-40			V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	$V_{GS} = -10\text{V}$			-10	nA
ピンチオフ電圧	V_P	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 10\mu\text{A}$			-6	V
ドレイン電流	$I_{DSS} \ast$	$V_{DS} = 10\text{V}$	0.6		24	mA
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS} = 10\text{V}, f = 1\text{kHz}$	1.5	7	12	$\text{m}\Omega$
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$		7.4		pF
帰還容量	C_{rss}	$V_{DS} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$		2.0		pF
雑音指数	NF	$V_{DS} = 10\text{V}, R_g = 1\text{M}\Omega, f = 1\text{kHz}$		1	2.5	dB
〃	NF	$V_{DS} = 10\text{V}, R_g = 1\text{M}\Omega, f = 30\text{Hz}$		3.5	10	dB

※ 2SK24 は 10V I_{DSS} により次のように分類しています。(単位mA)

0.6	C	1.5	1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0	10.0	G	24.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	------	---	------



● 高周波用 FET には 2SK25 ϕ p 374

■ AM1 バンド・カーラジオ高周波部 ϕ p 595

